

Борисенко И.В., Карпов М.А., Овсянников Г.А.

Переход металл–изолятор в эпитаксиальных пленках манганитов LaMnO_3 , выращенных магнетронным распылением 1

Бернацкий Д.П., Павлов В.Г.

Полевая эмиссионная микроскопия поверхности полевого эмиттера на основе $\text{Iг}-\text{С}-\text{Cs}$ 8

Раевский А.С., Раевский С.Б.

Присоединенные волны как волны, создаваемые распределенным источником бегущей волны 13

Грехов И.В., Гусин Д.В., Иванов Б.В., Рожков А.В.

Инжекционно-ионизационный механизм неустойчивости тока при выключении интегрального тиристора с полевым управлением 18

Артёменко С.Н., Августинович В.А., Артеев М.С.

Синхронный вывод СВЧ-энергии из резонаторов через пакет интерференционных переключателей 26

Когай В.Я., Вахрушев А.В.

Спонтанная взрывная кристаллизация и фазообразование в наноразмерной гетероструктуре селен/индий 34

Большаков А.Д., Дубровский В.Г., Yan Xin, Zhang Xia, Ren Xiaomin

Моделирование формирования InAs квантовых точек на боковой поверхности GaAs нитевидных нанокристаллов 39

Ефимов А.А., Иванов В.В., Багазеев А.В., Бекетов И.В., Волков И.А., Щербинин С.В.

Получение аэрозольных наночастиц в многоазорном газоразрядном генераторе 51

Жуков Б.Г., Куракин Р.О., Сахаров В.А., Бобашев С.В., Поняев С.А., Резников Б.И., Розов С.И.

Синхронный разгон двух тел mm-размера до гиперзвуковых скоростей в многоканальном рельсовом ускорителе 58

Парафин А.Е., Мастеров Д.В., Павлов С.А., Кревский М.А., Коробков Г.М., Кревский И.М.

Макет СВЧ-генератора с ВТСП дисковым резонатором в цепи обратной связи с низким уровнем фазового шума 63

Тихов С.В., Горшков О.Н., Антонов И.Н., Касаткин А.П., Коряжкина М.Н.

Особенности пиннинга уровня Ферми на границе раздела $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ с анодным оксидом и стабилизированным диоксидом циркония 72

Глявин М.Ю., Кунцевич А.Д., Лучинин А.Г., Мануилов В.Н., Морозкин М.В., Фокин А.П., Проявин М.Д.

Магнетронно-инжекционная пушка со сниженной температурой подогревателя и увеличенным временем жизни катода 80

Фирсов Д.Д., Комков О.С.

Фотомодуляционная ИК фурье-спектроскопия полупроводниковых структур: особенности фазовой коррекции и применение метода 87